

(Semi conducteurs).

II) Dopage (extrinsèque).

1) Définition.

Dopage: introduction d'impureté ds le cristal
but: aug le nb de porteur libres.

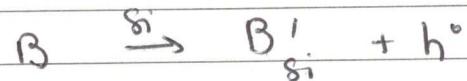
type N: inséré des atomes de type donneur d'électron afin d'obtenir une densité d'électrons \oplus grande

→ image poly \oplus tableau périodique pr montrer nb e^-

type P: inséré des atomes accepteur d' e^- afin de dimin la densité d' e^- \Rightarrow excès de trous.

→ image poly \ominus .. "

Ecriture: subs du Si par Bone ($1e^-$ en \ominus)



2) Energie de formations des défauts

$$[\text{défauts}] = \exp\left(\frac{-\Delta E_f}{k_B T}\right)$$

c° défauts

ΔE_f énergie de formation.

→ sur poly semi cond. \rightarrow diag de bandes

Ajouter partie sur nécessité des défauts de cristal nénig?